

## 5 V, +19.5 dBm出力, 1.8 GHz高周波広帯域増幅器

μPC1677C は各種高周波システムの中出力増幅用に開発したシリコン・モノリシックICです。  
1 GHzで+17 dBm出力が可能のため、無線通信機の送信段増幅器等に適しています。  
パッケージは8ピン・プラスチックDIPです。

### 特 徴

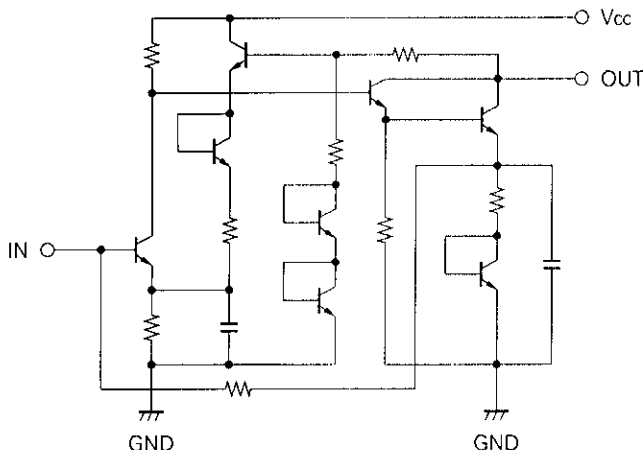
- 電源電圧：V<sub>CC</sub> = 5 V ± 0.5 V
- 高飽和出力電力：+19.5 dBm TYP. @0.5 GHz
- きわめて良好な周波数特性：1.8 GHz TYP.  
    @0.1 GHzでのゲインより3 dBダウンの周波数
- 高アイソレーション：34 dBm TYP. @0.5 GHz
- 高電力利得：24 dB TYP. @0.5 GHz

### オーダ情報

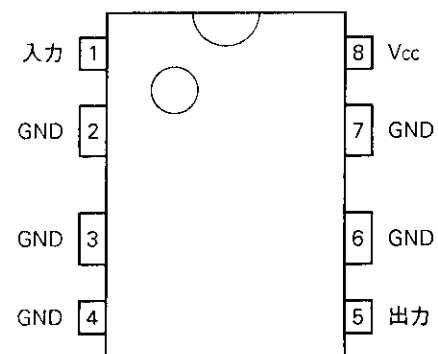
オーダ名称	パッケージ	包装形態	品質水準
μPC1677C	8ピン・プラスチックDIP (300 mil)	プラスチック・マガジン・ケース	標準(一般電子機器用)

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください(名称：μPC1677C)  
包装形態の詳細については当社発行の資料「半導体デバイスパッケージマニュアル」(IEI-635)をご覧ください。  
品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料「NEC半導体デバイスの品質水準」(IEI-620)をご覧ください。

### 等価回路



### 端子接続図 (Top View)



41608

注意 本製品は静電気等の過大入力により壊れる恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。

絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	T <sub>a</sub> = +25 °C, 5ピン, 8ピン	6	V
入力電力	P <sub>in</sub>	T <sub>a</sub> = +25 °C	+10	dBm
パッケージ許容損失	P <sub>D</sub>	50×50×1.6 mm 全銅箔両面ガラスエポキシ基板実装時 T <sub>a</sub> = +85 °C	750	mW
動作温度範囲	T <sub>opt</sub>		-45 ~ +85	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>		-55 ~ +150	°C

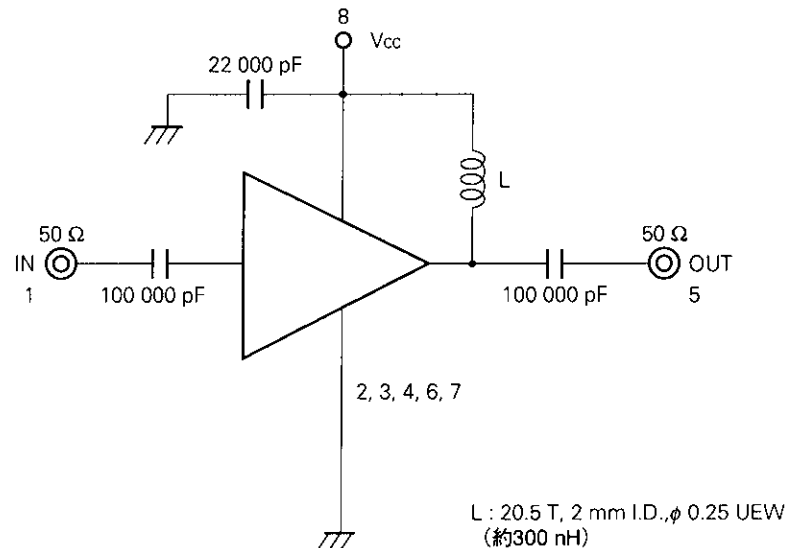
推奨動作範囲

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	4.5	5.0	5.5	V
動作温度範囲	T <sub>opt</sub>	-45	+25	+85	°C

電気的特性 (T<sub>a</sub> = +25 °C, V<sub>CC</sub> = 5 V, Z<sub>s</sub> = Z<sub>L</sub> = 50 Ω)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
回路電流	I <sub>CC</sub>	無信号時	63	77	93	mA
電力利得	G <sub>P</sub>	f = 0.5 GHz	22	24	26	dB
雑音指数	NF	f = 0.5 GHz		6.0	8.0	dB
上限動作周波数	f <sub>u</sub>	f = 0.1 GHzでのゲインより3 dBダウンの周波数	1.5	1.8		GHz
アイソレーション	ISL	f = 0.5 GHz	29	34		dB
入力側リターンロス	RL <sub>in</sub>	f = 0.5 GHz	10	13		dB
出力側リターンロス	RL <sub>out</sub>	f = 0.5 GHz	1	4		dB
飽和出力電力	P <sub>O(sat)</sub>	f = 0.5 GHz, P <sub>in</sub> = +3 dBm	+17.5	+19.5		dBm

## 測定回路（応用回路例）



## 出力側へのインダクタンス付加について

本ICは内部出力段トランジスタに約50 mA供給することにより中出力が得られるように設計されています。そこでVcc端子（8ピン）と出力端子（5ピン）間にインダクタンスを接続してください。インダクタンスの値としてはたとえば300 nHの大きなものを選んでください。

このようにインダクタンスを接続する目的は、DC的な効果と、AC的な効果を意図しています。DC的には出力段の電圧降下を最小にしながら出力段トランジスタへのDCバイアス印加を可能にし、高い出力を得ます。AC的には出力端子からインダクタンスでGNDに落としているのと同じで、この値を大きくすることによりハイ・インピーダンス負荷になり、十分なゲインを得ています。

インダクタンスの値を決定するポイントは上記のことから、高い周波数や低い周波数の範囲までを必要とする場合はインダクタンスを十分大きくすることです。本製品の特性評価では約300 nHの値を用いており、規格限界までの広帯域動作を確認しています。

## Vcc端子，入力端子へのコンデンサの決定について

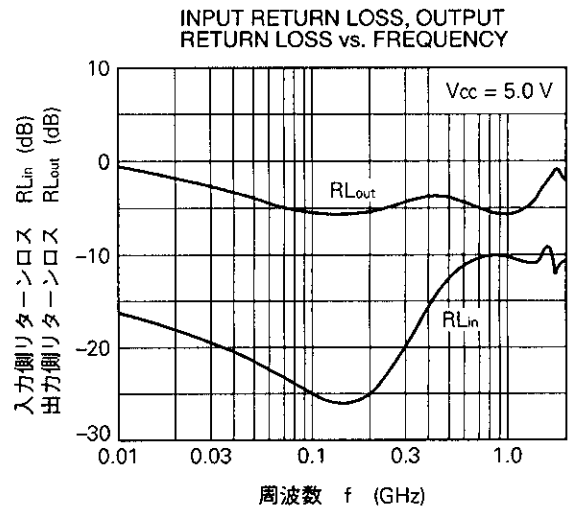
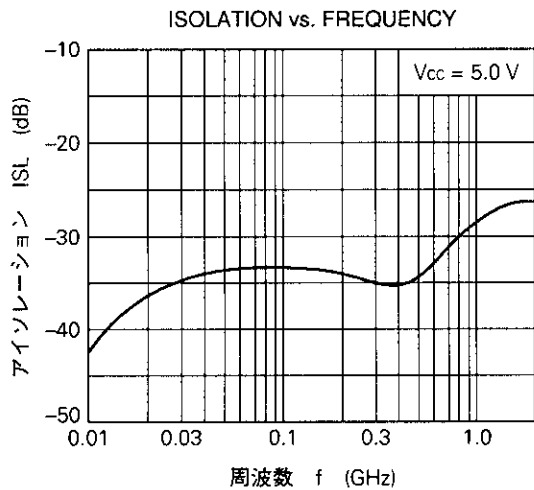
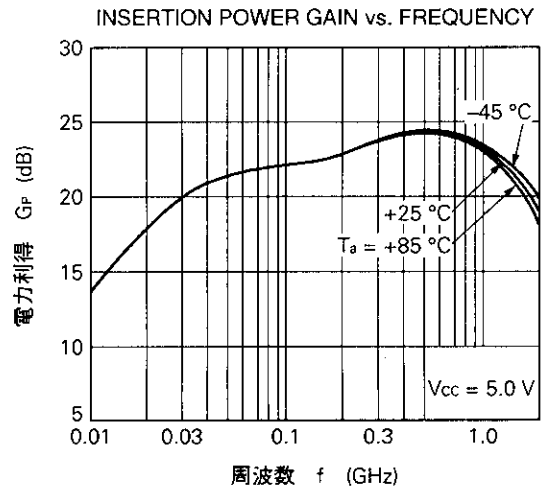
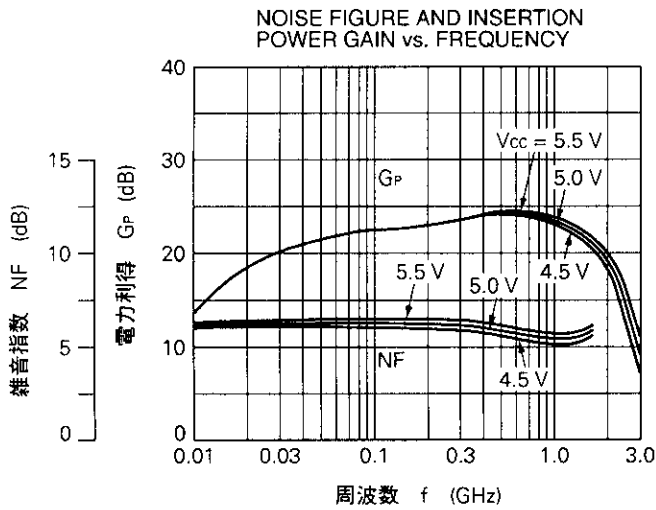
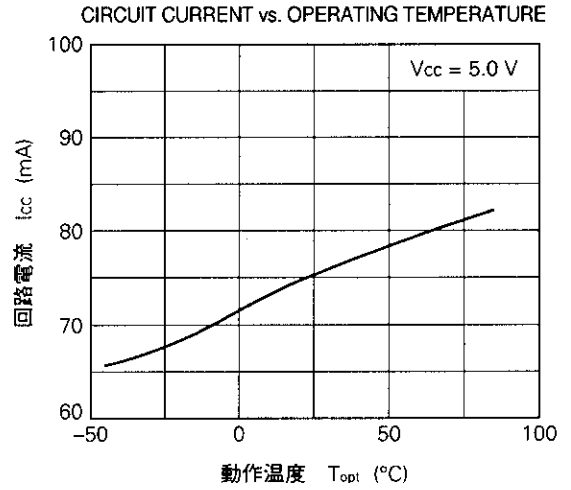
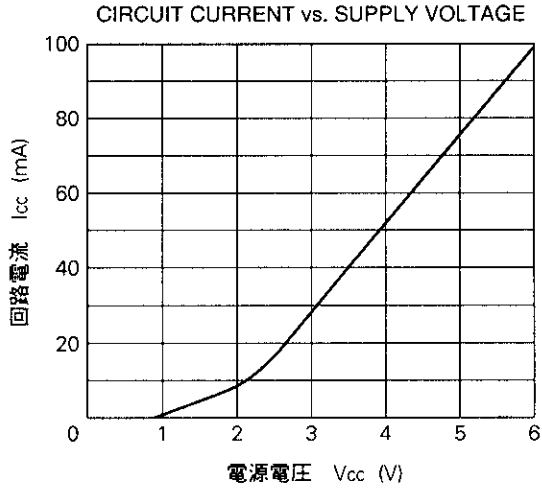
Vcc端子へのバイパス・コンデンサ，入出力のカップリング・コンデンサはいずれも22 000 pFおよび100 000 pF程度の値をご使用ください。

Vcc端子へバイパス・コンデンサを接続する目的は、Vcc端子とGND間のインピーダンスを0 Ωに近づけるためです。これにより、電源電圧変動に対し、安定したバイアス状態にすることができます。

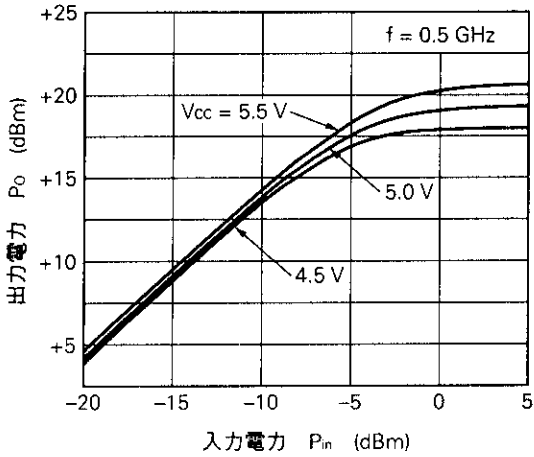
入出力端子へカップリング・コンデンサを接続する目的は、入出力端子と外付け回路をDC的にカットするためで、50 Ωの負荷に対してインピーダンスが十分低くなるように設定します。このコンデンサがハイパスフィルタとなり、DCまでの低い周波数をロスさせる訳です。

本製品の特性評価では100 MHz以上のゲインをフラットにした場合の周波数特性を確認するために100 000 pFを用いています。（100 MHzより低い周波数範囲を含む帯域で使用する場合は $f_c = 1 / (2 \pi RC)$ の関係から各コンデンサの値を大きくしてください。）

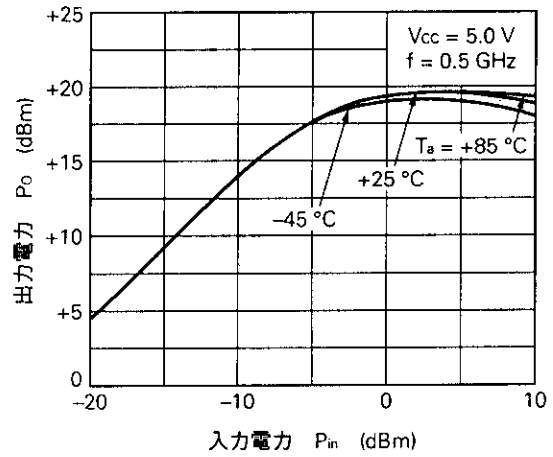
特性曲線 (Ta = +25 °C)



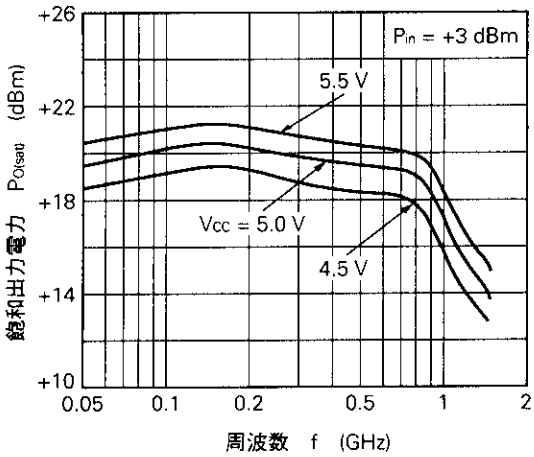
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER



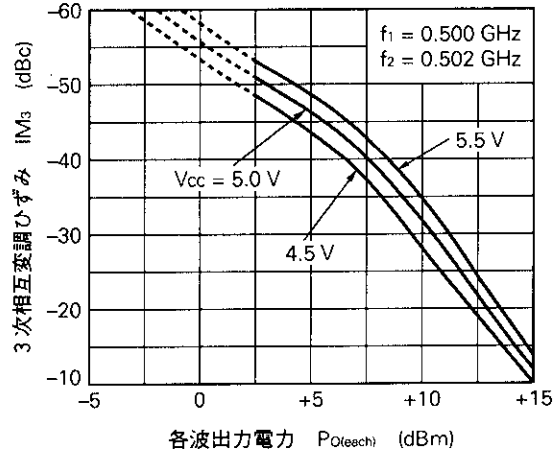
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER



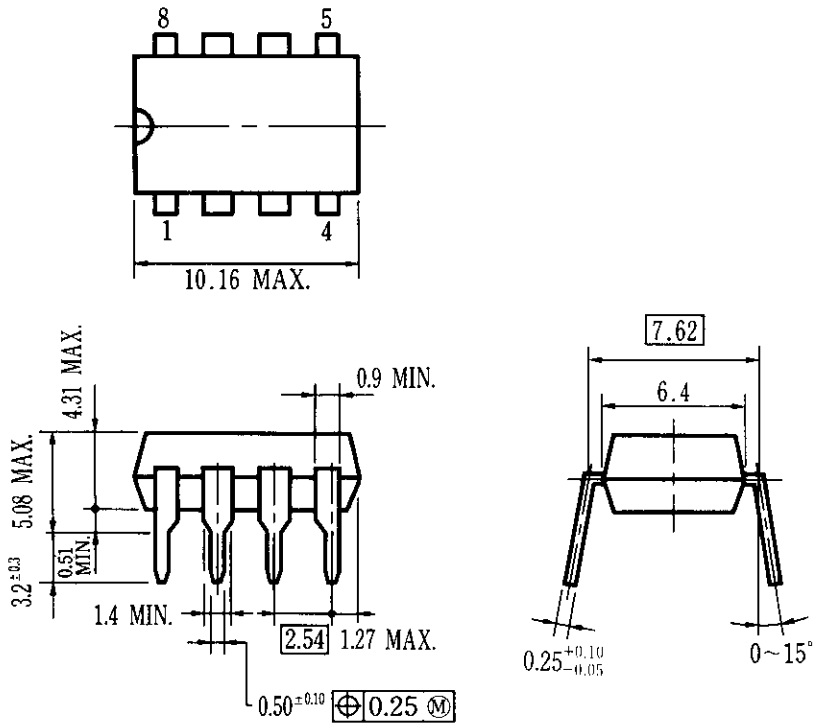
SATURATED OUTPUT POWER vs. FREQUENCY



THIRD ORDER INTERMODULATION DISTORTION vs. OUTPUT POWER OF EACH TONE



8ピン・プラスチック DIP (300 mil) 外形図(単位: mm)



P8C-100-300B, C

### 使用上の注意事項

- (1) 高周波プロセスを使用していますので、静電気等の過大入力にご注意願います。
- (2) アースパターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください（異常発振の防止のため）。
- (3) 接地端子は極力短く配線してください。
- (4) Vcc端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。

### 半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

### 挿入タイプ

μPC1677C

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260℃以下、時間：10秒以内	

注. 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱方式は除く）。

[メモ]

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は、航空宇宙機器、海中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療用機器などに推奨できる製品を標準的には用意しておりません。当社製品をこれらの用途にご使用をお考えのお客様、および、「標準」品質水準品を当社が意図した用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

当社推奨の用途例

標準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、工作機械、産業用ロボット、AV機器、家電等

特別：輸送機器（列車、自動車等）、交通信号機器、防災／防犯装置等

- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 92.6

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

コンシューマ半導体販売事業部 OA半導体販売事業部 インダストリー半導体販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2755
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208
北海道支社 札幌 (011)231-0161 東北支社 仙台 (022)261-5511 岩手支店 盛岡 (0196)51-4344 山形支店 山形 (0236)23-5511 郡山支店 郡山 (0249)23-5511 いわき支店 いわき (0246)21-5511 長岡支店 長岡 (0258)36-2155 水戸支店 水戸 (0292)26-1717 神奈川支社 横浜 (045)324-5511 群馬支店 高崎 (0273)26-1255 太田支店 太田 (0276)46-4011 宇都宮支店 宇都宮 (0286)21-2281	小山支店 小山 (0285)24-5011 長野支社 長野 (0262)35-1444 松本支店 松本 (0263)35-1666 上諏訪支店 上諏訪 (0266)53-5350 甲府支店 甲府 (0552)24-4141 埼玉支店 大宮 (048)641-1411 立川支店 立川 (0425)26-5981 千葉支社 千葉 (043)238-8116 静岡支店 静岡 (054)255-2211 沼津支店 沼津 (0559)63-4455 浜松支店 浜松 (053)452-2711 北陸支社 金沢 (0762)23-1621	福井支店 福井 (0776)22-1866 富山支店 富山 (0764)31-8461 京都支社 京都 (075)344-7824 神戸支社 神戸 (078)332-3311 中国支社 広島 (082)242-5504 鳥取支店 鳥取 (0857)27-5311 岡山支店 岡山 (086)225-4455 四国支社 高松 (0878)36-1200 新居浜支店 新居浜 (0897)32-5001 松山支店 松山 (0899)45-4111 九州支社 福岡 (092)271-7700 北九州支店 北九州 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体応用技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-8881	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体応用技術本部 中部応用システム技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2762	
半導体応用技術本部 西日本応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	